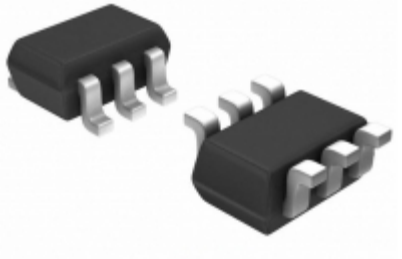









	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1405BDH-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>
	<p>Datenblätter:  SI1405BDH-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 17585 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI1405BDH-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	17585 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta), 2.27W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	112 mOhm @ 2.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	950mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	305pF @ 4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI1405BDH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1405BDH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1405BDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1405BDH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1404DL-T1-GE3 V SI1404DL-T1-GE3 V</p>	 <p>SI1405BDH Vishay Precision Group SI1405BDH Vishay</p>	 <p>SI1405DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1405BDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>
 <p>SI1405DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1405BDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SOT363</p>	 <p>SI1405DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1405DL-T1 VISHAY SI1405DL-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI1400DL-T1-GE3	 SI1400DL-T1-GE3	 SI1401EDH-T1-GE3	 SI1401EDH-T1-GE3	 SI1402DH-T1-GE3
 SI1402DH-T1-GE3	 SI1403BDL-T1-E3	 SI1403BDL-T1-E3	 SI1403BDL-T1-GE3	 SI1403BDL-T1-GE3
 SI1403CDL-T1-GE3	 SI1403CDL-T1-GE3	 SI1403DL	 SI1403DL-T1	 SI1403DL-T1-E3
 SI1403DL-T1-GE3	 SI1404BDH-T1-E3	 SI1404BDH-T1-E3	 SI1404DH-T1	 SI1404DH-T1-E3
 SI1404DH-T1-GE3	 SI1404DL-T1-GE3	 SI1405BDH-T1-E3	 SI1405BDH-T1-E3	 SI1405BDH-T1-GE3
 SI1405DL-T1	 SI1405DL-T1-E3	 SI1405DL-T1-E3	 SI1406DH	 SI1406DH-T1
 SI1406DH-T1-E3	 SI1406DH-T1-E3	 SI1406DH-T1-GE3	 SI1406DH-T1-GE3	 SI1407DL
 SI1407DL-T1	 SI1407DL-T1-E3	 SI1407DL-T1-GE3	 SI1410EDH	 SI1410EDH-T1
 SI1410EDH-T1-E3	 SI1410EDH-T1-E3	 SI1410EDH-T1-GE3	 SI1413DH-T1	 SI1413EDH
 SI1413EDH-T1	 SI1413EDH-T1-E3	 SI1413EDH-T1-E3	 SI1413EDH-T1-GE3	 SI1413EDH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited